

『XAFS の基礎と応用』 第 1～5 刷正誤表

この度は、標記書籍をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
標記書籍に誤りがありました。訂正し、深くお詫び申し上げます。

ページ数	位置	誤	正
170	下から 5 行目	図 4.4.4 に示した SiNO の測定例からわかるように ⁵⁵⁾ ,	図 4.4.4 に次世代 MOSFET として期待される SiC の界面、 <u>SiON/SiC(0001)の測定結果を示した⁵⁵⁾</u> 。これからわかるように、
171	図 4.4.4 キャプション	<u>SiNO</u> の O K 吸収端 XANES	<u>SiON/SiC(0001)</u> の O K 吸収端 XANES